

2DI75S-050A(75A)

富士パワーモジュール

パワートランジスタモジュール

POWER TRANSISTOR MODULE

■特長 : Features

- フリー・ホイーリング・ダイオード内蔵 Including Free Wheeling Diode
- h_{FE} が高い High D.C. Current Gain
- 絶縁形 Insulated Type

■用途 : Applications

- 大電力スイッチング High Power Switching
- AC モータ制御 A.C Motor Controls
- DC モータ制御 D.C Motor Controls
- 無停電電源装置 Uninterruptible Power Supply

■定格と特性 : Maximum Ratings and Characteristics

● 絶対最大定格 : Absolute Maximum Ratings

Items	Symbols	Ratings	Units
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	600	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	600	V
コレクタ・エミッタ間電圧(SUS)	$V_{CEO(SUS)}$	450	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	6	V
コレクタ電流	DC 1ms DC	I _c I _{CP} -I _c	A A A
ベース電流	DC 1ms	I _B I _{BP}	A A
コレクタ損失	one Transistor two Transistors	P _c P _c	W W
接合部温度	T _j	+150	°C
保存温度	T _{stg}	-40 ~ +125	°C
重量	m	235	g
絶縁耐圧 AC. 1min	V _{iso}	2000	V
締付けトルク	Mounting ※1 Terminals ※1	35 35	kg·cm kg·cm

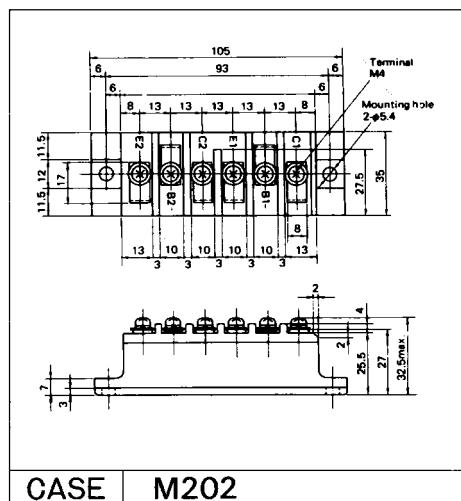
● 電気的特性 : Electrical Characteristics ($T_j=25^\circ\text{C}$)

Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	$I_{CBO}=1\text{mA}$	600			V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	$I_{CEO}=1\text{mA}$	600			V
コレクタ・エミッタ間電圧(SUS)	$V_{CEO(SUS)}$	$I_c=1\text{A}$	450			V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	$I_{EBO}=150\text{mA}$	450			V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE}	$I_c=150\text{A}, V_{EB}=6\text{V}, -I_B=2\text{A}$				V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	$I_{EBO}=150\text{mA}$	6			V
コレクタ・エミッタ間電圧	I_{CBO}	$V_{CBO}=600\text{V}$			1.0	mA
エミッタ・エミッタ間電圧	I_{EBO}	$V_{EBO}=6\text{V}$			150	mA
コレクタ・エミッタ間電圧	$-V_{CE}$	$-I_c=75\text{A}$			1.5	V
直流電流増幅率	h_{FE}	$I_c=75\text{A}, V_{CE}=5\text{V}$	100			—
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(Sat)}$	$I_c=75\text{A}, I_B=1.5\text{A}$			2.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(Sat)}$				2.5	V
スイッチング時間	t_{on} t_{sig} t_f	$I_c=75\text{A}, -I_B=3\text{A}$ 前段FET BUZ41A組合せ			1.2 8.0 1.5	μs μs μs
逆回復時間	t_{rr}	$-I_c=75\text{A}, V_{BE}=-6\text{V}, -di/dt=75\text{A}/\mu\text{s}$			0.6	μs

● 热的特性 : Thermal Characteristics

Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
熱抵抗	$R_{th(j-c)}$	Transistor			0.35	°C/W
熱抵抗	$R_{th(j-c)}$	Diode			0.85	°C/W
熱抵抗	$R_{th(c-f)}$	With Thermal Compound		0.05		°C/W

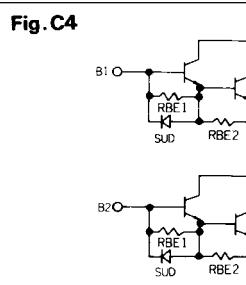
■外形寸法 : Outline Drawings



CASE M202

■等価回路

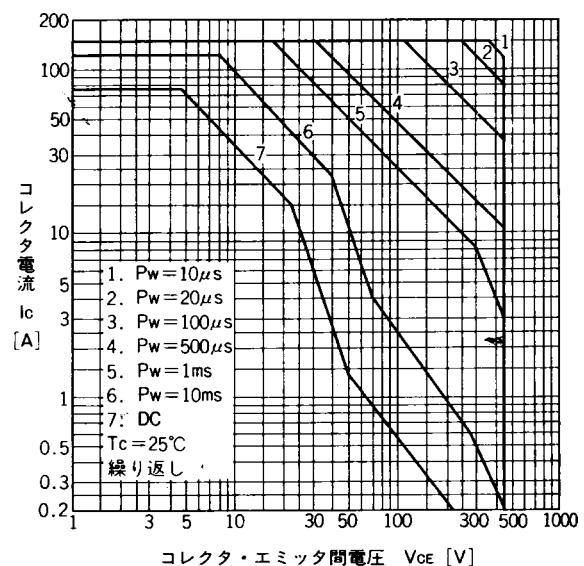
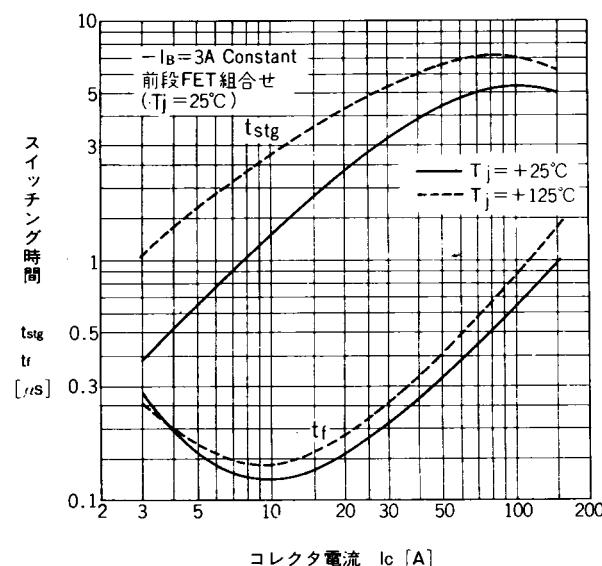
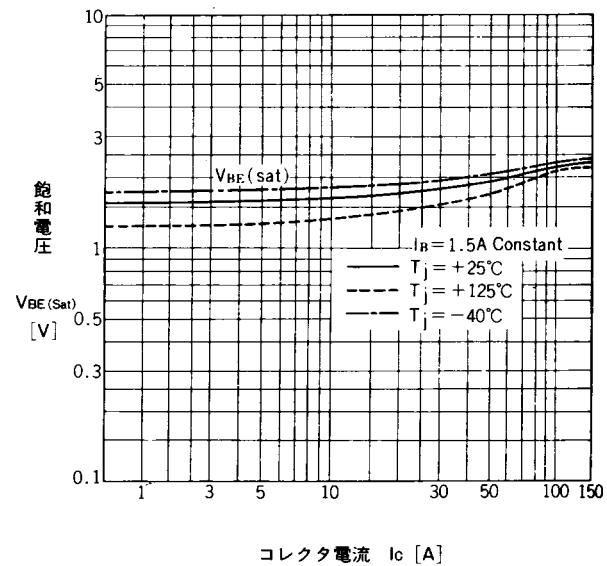
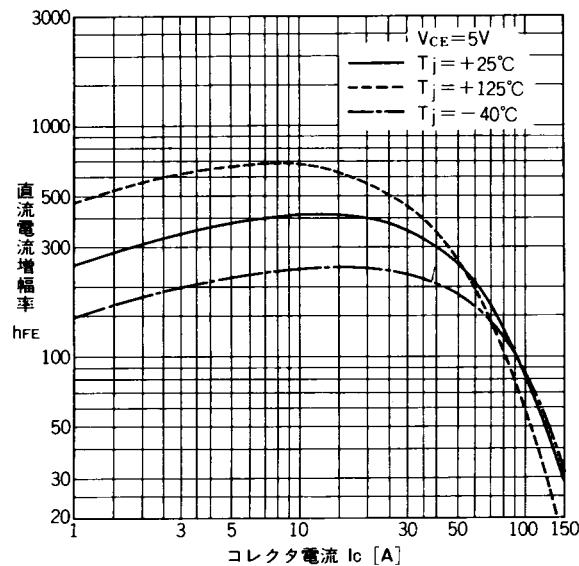
Equivalent Circuit Schematic

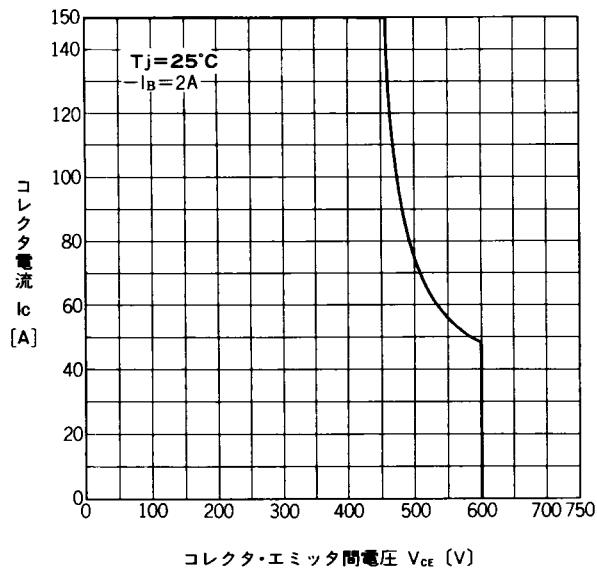


Note:

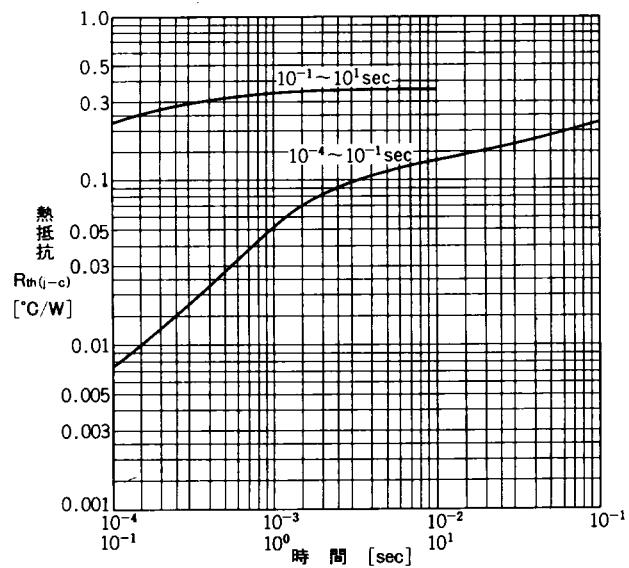
※1: 推奨値 Recommendable Value
M5: 25~30 kg·cm

■特性曲線：Characteristics

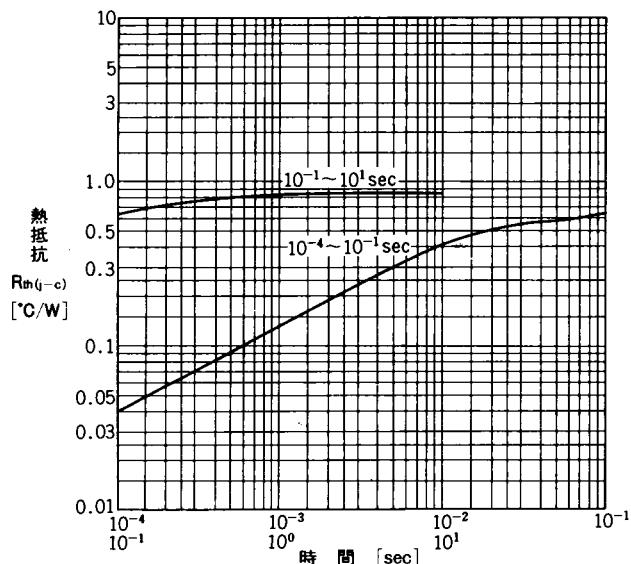




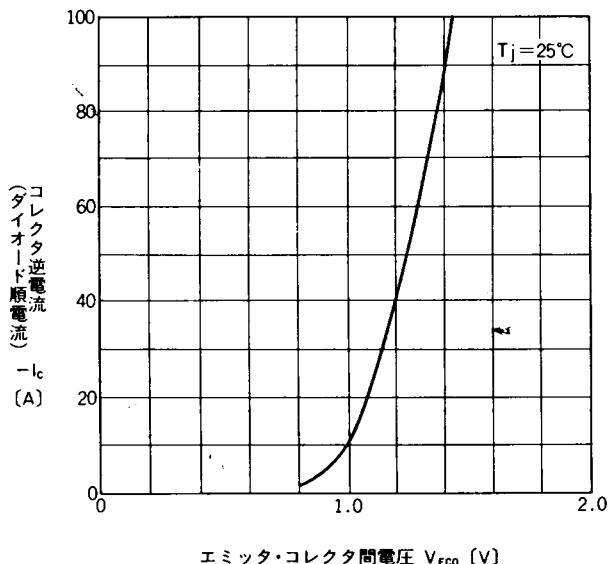
安全動作領域(逆バイアス)
Reverse Biased Safe Operating Area



過渡熱抵抗(トランジスタ)特性
Transient Thermal Resistance
(Transistor)



過渡熱抵抗(ダイオード)特性
Transient Thermal Resistance (Diode)



高速フリーホイーリングダイオード順電圧
Forward Voltage of Free Wheeling Diode